



9012 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：A043BJ-00

芯片厚度： $240 \pm 20 \mu\text{m}$

管芯尺寸： $430 \times 430 \mu\text{m}^2$

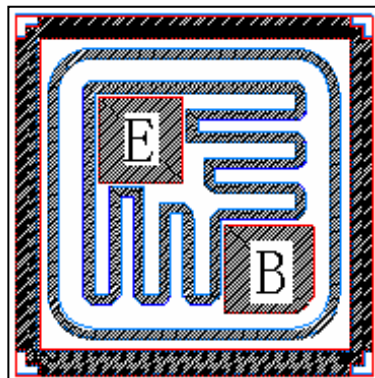
焊位尺寸：B 极 $107 \times 107 \mu\text{m}^2$ ，E 极 $101 \times 101 \mu\text{m}^2$

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：SS9012，H9012，8550S

管芯示意图



极限值（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

T_{stg}	贮存温度	-55~150
T_j	结温	150
P_C	集电极耗散功率	625mW
V_{CBO}	集电极—基极电压	-40V
V_{CEO}	集电极—发射极电压	-20V
V_{EBO}	发射极—基极电压	-5V
I_C	集电极电流	-500mA

电参数（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{\text{CB}}=-25\text{V}$ ， $I_{\text{E}}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{\text{EB}}=-3\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=0$
h_{FE}	直流电流增益	80		390		$V_{\text{CE}}=-1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=-50\text{mA}$
		40				$V_{\text{CE}}=-1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=-500\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			-0.6	V	$I_{\text{C}}=-500\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	$I_{\text{C}}=-500\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{on})$	基极—发射极导通电压	-0.6		-0.73	V	$V_{\text{CE}}=-1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=-10\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-40			V	$I_{\text{C}}=-100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{E}}=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	$I_{\text{C}}=-1\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_{\text{E}}=-100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{C}}=0$